

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2025-059

## 深圳安培龙科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下：

### 一、发明专利 1：

发明专利名称：基于 SOI 的低零漂压力芯片高效制备方法及系统

专利号：ZL 2025 1 0736419.1

专利权人：深圳安培龙科技股份有限公司

专利申请日：2025 年 06 月 04 日

授权公告日：2025 年 08 月 15 日

专利权期限：本专利的专利权期限为 20 年。

本发明提供一种基于 SOI（Silicon-On-Insulator，绝缘体上硅）的低零漂压力芯片高效制备方法及系统，分析现有制备材料对应的材料性能参数，从预设材料库中筛选出现有制备材料对应的协同制备材料；对压力芯片进行有限元仿真处理，得到压力芯片仿真模型，计算压力芯片仿真模型对应的结构挠曲度；配置压力芯片的模拟环境条件，计算压力芯片仿真模型对应的零点漂移离散度；计算出压力芯片仿真模型对应的芯片温漂系数；从协同制备材料和现有制备材料中确定压力芯片对应的高效制备材料，对芯片制备路径进行参数优化，得到低零漂制备路径，执行对压力芯片的制备处理，得到芯片成品。本发明可以提高 SOI 的低零漂压力芯片的制备效率，应用于机器人、汽车、工业、航空航天等各种需要测量压力和力传感器的领域。

本项发明专利涉及公司自主研发的一种基于 SOI 的低零漂压力芯片的创新型核心制备技术，该技术目前尚未量产，短期内不会对公司的经营业绩构成重大影响，未来将陆续在公司相关业务中应用。本次有利于公司发挥产品的自主知识

产权及技术创新优势，对提升了企业核心竞争力、促进市场拓展及研发创新等方面都具有重要意义。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2025年8月18日